JP2000224391

Title: LASER RECORDER

Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a laser recorder where a utilizing efficiency of a laser beam can be enhanced and an image or the like can be recorded with a simple configuration independently of effect of a secular change with high precision.

SOLUTION: A collimator lens 26 collimates a far field pattern of a laser beam L outputted from a semiconductor laser LD into a parallel luminous flux and the image is formed on an aperture member 20 through a 1st lens 18. The aperture member 20 shapes the formed far field pattern in the main scanning direction and the subscanning direction and the shaped beam is led to a recording film F via a 2nd lens 22 and a 3rd lens 24, where the image is recorded. In this case, the aperture member 20 restricts the fluctuation in the laser beam L in the main scanning direction and the subscanning direction.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出額公開番号 特開2000-224391 (P2000-224391A)

(43)公開日 平成12年8月11日(2000.8.11)

(51) Int.C1.7		護別凯号	FI			テーマコート*(多考)
H04N	1/113		H04N	1/04	104B	2 C 3 6 2
841J	2/44		B41J	3/00	D	5 C O 7 2

審査請求 未請求 請求項の数? OL (全 7 頁)

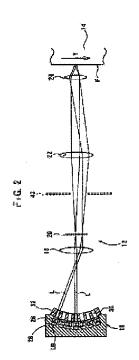
(21)出願番号	特願平11-22322	(71) 出願人 000005201
		富士写真フイルム株式会社
(22)出験日	平成11年1月29日(1999.1.29)	神奈川県南足柄市中沼210番地
,,,,_,,,,,		(72)発明者 宮川 一郎
		神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富
		士写真フィルム株式会社内
		(72)発明者 砂川 第
		神奈川県足柄上郡彌成町宮台798番地 富
		士写真フイルム株式会社内
		(74)代理人 10007/665
		弁理士 千葉 剛宏 (外1名)
		Fターム(参考) 2C362 AAO3 AA13 BA29 BA85 CB71
		50072 AA03 CA02 CA06 DA02 DA18
		HAO2 HBIO JAO7 RA12 XAO5

(54) 【発明の名称】 レーザ記録装置

(57)【要約】

【課題】レーザビームの利用効率を向上させることができるとともに、経時的変化の影響によらず簡易な構成で 画像等を高精度に記録することのできるレーザ記録装置 を提供することを目的とする。

【解決手段】半導体レーザしりから出力されたレーザビームしのファーフィールドパターンは、コリメータレンズ26によって平行光束とされた後、第1レンズ18によってアパーチャ部材20上に結像される。結像されたファーフィールドパターンは、アパーチャ部材20によって主走査方向および副走査方向にビーム整形された後、第2レンズ22および第3レンズ24を介して記録フイルムドに導かれることで、画像の記録が行われる。この場合、レーザビームしの主走査方向および副走査方向に対する変動がアパーチャ部材20によって規制される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】記録媒体に対してレーザビームを2次元的 に走査することで画像等を記録するレーザ記録装置にお いて、

レーザビームを出力するレーザ光源と、

前記レーザビームのファーフィールドパターンを前記レーザ光源および前記記録媒体間に結像する結像レンズと、

前記ファーフィールドパターンの結像位置に配設され、 少なくとも副走査方向の幅が前記ファーフィールドパタ ーンの前記副走査方向の幅よりも所定量だけ狭く設定されるアパーチャ部材と、

を備えることを特徴とするレーザ記録装置。

【請求項2】請求項1記載の装置において 前記レーザ 光源の活性層接合面に対して平行な方向を前記副走査方 向に設定することを特徴とするレーザ記録装置。

【請求項3】請求項1または2記載の装置において 前 記レーザ光源は、2次元的に配置された複数の半導体レ ーザからなることを特徴とするレーザ記録装置。

【請求項4】請求項3記載の装置において 前記複数の 半導体レーザは、前記各レーザビームを前記結像レンズ の前側焦点面上で交差させて前記結像レンズに導くべ く、球面上に配設されることを特徴とするレーザ記録装 置。

【請求項5】請求項4記載の装置において 前記各レーザビームの交差点は、前記前側焦点面上で前記結像レンズの光軸から所定距離離間した点に設定されることを特徴とするレーザ記録装置。

【請求項6】請求項1~5のいずれかに記載の装置において 前記結像レンズにより結像される前記ファーフィールドパターンの副走査方向に対する強度分布の幅が、前記結像レンズにより結像される前記レーザビームのユアフィールドパターンの副走査方向に対する強度分布の幅よりも小さく設定されることを特徴とするレーザ記録装置。

【請求項7】請求項1~5のいずれかに記載装置において

前記結像レンズにより結像される前記ファーフィールドパターンの副走査方向に対する強度分布の幅d 0 // と、前記結像レンズにより結像される前記レーザビームのニアフィールドパターンの副走査方向に対する強度分布の幅d 0 // と、前記ファーフィールドパターンの結像位置に配設されるアパーチャ部材の開口部の副走査方向に対する幅D // とが、d 0 // ′ > d 0 // ≧ D // となる関係に設定されることを特徴とするレーザ記録装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、記録媒体に対して レーザビームを2次元的に走査することで画像等を記録 するレーザ記録装置に関する。

[0002]

【従来の技術】画像記録の分野において、画像処理の施されたデジタル信号に基づき、レーザ光学系を駆動制御し、記録媒体に面積変調による画像を露光記録するレーザ記録装置が用いられている。なお、画像が露光記録された記録媒体は、必要に応じて現像機に供給され、潜像から顕像に変換される。

【0003】このようなレーザ記録装置として、複数の 半導体レーザから出力されたレーザビームをコリメート した後、平行光東からなるレーザビームの光路中にアパーチャ部材を配設し、前記アパーチャ部材の開口による レーザビームの関口像を感光材料上に結像するように構 成したものがある(特開平6-186490号)。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】この場合、前記の従来 技術では、半導体レーザの設定位置のずれがアパーチャ 部材によって吸収されるため、高精度な画像記録が可能 である。しかしながら、アパーチャ部材は、コリメート されたレーザビームの光路中に配設されているため、レ ーザビームの光量がアパーチャ部材によって大きく減衰 されてしまい、レーザビームの利用効率が低下する不具 合がある。また、開口の像を感光材料上に結像するため に、多数のレンズ系が必要となる。従って、レンズによ る収差の影響が大きく、また、レーザビームの光量が多 数のレンズを通過することによってさらに減衰する不具 合がある。

【0005】本発明は、前配の不具合を解消すべくなされたものであり、レーザビームの利用効率を向上させることができるとともに、経時的変動の影響によらず簡易な構成で画像等を高精度に記録することのできるレーザ記録装置を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明に係るレーザ記録 装置では、レーザビームを結像レンズによって集光する ことでファーフィールドパターンを結像し、その結像位 置に配置したアパーチャ部材を用いて前記ファーフィー ルドパターンを少なくとも副走査方向に整形して記録媒 体に導くことにより、画像等を形成する。

【0007】この場合、レーザビームの副走査方向に対する位置変動は、ファーフィールドパターンが結像された位置に配置されたアパーチャ部材によって効果的に抑制される。また、前記アパーチャ部材をファーフィールドパターンの結像位置に配置することで、レーザビームの光量を大量に削減することがなく、従って、レーザビームを記録媒体に効率的に導いて画像等を高精度に記録することができる。なお、主走査方向に対するレーザビームの位置すれば、記録タイミングを電気的に制御することで容易に補正することができる。

[0008]

【発明の実施の形態】図1および図2は、第1実施形態

のレーザ記録装置10を示す。このレーザ記録装置10は、露光ヘッド12から射出された複数のレーザビーム しをドラム14上に装着された記録フイルムF(記録媒体)に照射することで、面積変調画像を記録するように したものである。なお、記録フイルムFには、主走査方 向(矢印X方向)に回転するドラム14に対して露光ヘッド12を副走査方向(矢印Y方向)に移動させること で、2次元画像が形成される。また、面積変調画像と は、レーザビームしをオンオフ制御することで、記録フ イルムF上に複数の画素を形成し、その画素の占める面 積によって所定の階調が得られるようにした画像であ

【0009】露光ヘッド12は、図3に示す複数のレーザビームしを出力する発光ユニット16と、前記発光ユニット16から出力された各レーザビームしを焦点面上で集光させる第1レンズ18と、前記第1レンズ18の焦点面に配置されるアパーチャ部材20と、各レーザビームしを記録フイルムF上に集光する第2レンズ22および第3レンズ24とを備える。

【0010】発光ユニット16は、半導体レーザLDおよびコリメータレンズ26によって構成される複数の発光部28と、導光路30を有し各発光部28の装着されるマウント32とから構成される。なお、半導体レーザLDは、コリメータレンズ26の焦点位置に配置される。

【0011】ここで、半導体レーザレDは、機多モード 半導体レーザである屈折率導波型半導体レーザからな り、基本的には、図4に示すように、p型の半導体基板 33とn型の半導体基板35との間に活性層38を設 け、前記半導体基板33、35に設けた電極40、42 間に所定の電圧を印加することにより、活性層38から レーザビームしを出力するように構成されている。この 場合、一方の電極40は幅が規制されており、この幅に 対応して活性層38に沿った方向の屈折率が制御されて いる。従って、半導体レーザレDから出力されるレーザ ビームしのニアフィールドパターンは、図4に示される ように、電極40の幅に対応した活性層38の接合面方 向に幅広で且つ略矩形状となる。また、活性層38の厚 み方向に対しては、その厚みに対応した幅狭の形状とな る。

【0012】このように構成される半導体レーザLDは、球面状に構成されるマウント32に装着されており、各半導体レーザLDから出力されたレーザビームLは、図3に示すように、第1レンズ18の前側焦点位置において交差する。

【0013】アパーチャ部材20は、第1レンズ18の 後側焦点面から光軸に沿って記録フイルムF側に所定距 離変位したファーフィールドパターンの結像位置に配置 されており、図5に示すように、各半導体レーザしDに 対応して複数の開口部34が配設される。開口部34 は、略正方形状に構成されている。この場合、各半導体レーザLDから出力されたレーザビームLのビームスポット36は、前記開口部34によって副走査方向(矢印Y方向)の幅が規制される。また、開口部34は、本実施形態においては、主走査方向(矢印X方向)に配列された開口部34が副走査方向(矢印Y方向)に所定距離 ムだけずらして配置されることにより、同時に49点のビームスポット36が記録フイルムF上に記録されるように構成されている。

【0014】なお、半導体レーザLDから出力されるレーザビームしは、活性層38と直交する方向に対する発散角度が大きいため、アパーチャ部材20上に結像されるレーザビームLのファーフィールドパターンのビームスポット36は、図5に示すように、主走査方向(矢印X方向)に長尺となる略楕円状となる。

【0015】第1実施形態に係るレーザ記録装置10 は、基本的には以上のように構成されるものであり、次 に、その作用効果について説明する。

【0016】画像情報に応じて変調され、各半導体レーザLDの活性層38より出力されたレーザビームLのエアフィールドパターン(図4参照)は、図3の点線で示すように、コリメータレンズ26によって平行光束とされて第1レンズ18の前側焦点を通過した後、第1レンズ18の後側焦点面上に集光される。

【0017】一方、レーザビームLのファーフィールドパターンは、図6に示すように、コリメータレンズ26の後側焦点位置P0の面上に形成されており、このファーフィールドパターンは、図3の実線で示すように、第1レンズ18の後側焦点面よりも後方の位置P0′の面上に結像される。

(0018)この場合、位置PO'の面には、主走査方向(矢印X方向)および副走査方向(矢印Y方向)に対して、レーザビームしのファーフィールドパターンのビームスポット36の幅よりも狭く設定された幅からなる略正方形状の複数の開口部34を有したアパーチャ部材20が配置されている(図5参照)。そして、これらの複数の開口部34は、半導体レーザしDから出力された各レーザビームしに対応して配置されている。

【0019】従って、アパーチャ部材20を通過した各レーザビームしは、主走査方向(矢印X方向)および副走査方向(矢印Y方向)の位置が前記アパーチャ部材20によって規制されるため、半導体レーザレDの位置ずれ等の影響を受けることなく、第2レンズ22および第3レンズ24を介して記録フイルムF上の所定位置に高精度に集光される。また、主走査方向(矢印X方向)に対するビームスポット36の広がりがレンズ系を用いることなく開口部34によって容易に整形されるため、一層良好な画像を形成することができる。

【0020】なお、このようにしてレーザビームLの整形を行う場合、アパーチャ部材20の閉口部34によっ

て回折光が生じる。そこで、図2の点線で示すように、 第2レンズ22の前側焦点位置近傍に遮蔽板43を配置 し、この遮蔽板43によって一次回折光以上のレーザビ ームしを遮断するようにすれば、記録フイルムF上での レーザビームしの記録位置が焦点深度方向にずれた場合 における画像のぼけを抑制することができる。

【0021】ところで、ファーフィールドパターンを用 いて画像の記録を行う場合、ニアフィールドパターンの 影響をも考慮する必要がある。そこで、この点について 以下に考察する。

 $Sff \sim 2 \cdot f1 \cdot sin (\theta ///2)$

となる。後側焦点位置POから第1レンズ18の前側主 点位置までの光学距離をLO、第1レンズ18の焦点距 離をf2とすると、レーザビームしのファーフィールド パターンの像は、第1レンズ18の後側主点位置からよ

 $d0//' = Sff \cdot f2/(L0-f2)$

 $= 2 \cdot f \cdot 1 \cdot f \cdot 2 \cdot \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) / (L0 - f \cdot 2) \cdots (2)$

/ は、

となる。一方、ニアフィールドパターンの像の副走査方 dO//=W//-f2/f1

となる。

【0024】ここで、図7に示すように、d0//くd0 //′であると、ファーフィールドパターンを記録フイル ムF上に結像させているため、記録フイルムFの焦点深 度方向に対する位置変動によってレーザビームしのビー ムスポット36の径が大きく変動してしまう懸念があ る。一方、図8に示すように、d0//′≤d0//である と、記録フイルムFが焦点深度方向に位置変動したとし ても、ビームスポット36の径が大きく変動することが なく、安定した状態で画像等を記録することができる。 従って、ファーフィールドパターンが集光される位置に 設定されるアパーチャ部材20の開口部34の幅をD// とすると、図9に示すように、レーザ記録装置10を構 成する光学系を、d 0 //≥d 0 //′ > D // の関係を満足 するように設計することで焦点深度方向に対する位置変 動の影響を小さく抑えることができる。

【0025】また、d0//′ >d0//の場合でも、d0 //′ >d0//≥D//の関係を満足するように、アパーチ ャ部材20の開口部34の幅D//を設定することによ り、副走査方向(矢印Y方向)および焦点深度方向に対 する位置変動の影響を小さく抑えることができる。

【0026】なお、前記のように構成されるレーザ記録 装置10において、レーザビームLの一部がアパーチャ 部材20によって反射され、それがたまたま半導体レー ザレDに再入力されると、モードホッピングが発生する ことが懸念される。そこで、図10に示すように、アパ ーチャ部材20の前段に配置される第1レンズ18を、 その光軸に直交する面内で所定量ずらして設定すれば、 点線で示すように、アパーチャ部材20によって反射さ れたレーザビームLが半導体レーザLDに再入力する事 熊を回避することができる。例えば、光軸に対するずれ

【0022】上述したように、レーザビームLのファー フィールドパターンは、アパーチャ部材20の位置P 0′の面上に結像されるが、二アフィールドパターン は、第1レンズ18の後側焦点面上に結像される。

【0023】この場合、図6に示すように、半導体レー ザLDから出力されるレーザビームLの副走査方向(矢 印Y方向) に対する広がりの角度を 8//、コリメータレ ンズ26の焦点距離を f 1とすると、ファーフィールド パターンの副走査方向(矢印Y方向)に対する後側焦点 位置POでの幅Sffは、

 \cdots (1) 2 · L O / (L O - f 2) だけ記録フイルムF側に離れ

た位置PO1に結像される。このファーフィールドパタ

ーンの像の副走査方向(矢印Y方向)に対する幅dO/

向(矢印Y方向)に対する幅 d 0 //は、

量をδαとすると、アパーチャ部材20によって反射さ れたレーザビームLは、2·δαだけずれることにな る。従って、コリメータレンズ26を通過したレーザビ ームLのビーム径をBとした場合、B<2・δαとなる ように設定し、必要に応じてこの反射光に対する遮光板 を設けることにより、半導体レーザLDのモードホッピ ングを好適に回避することができる。

... (3)

【0027】図11は、第2実施形態のレーザ記録装置 50の構成を示す。このレーザ記録装置50では、露光 ヘッド52を構成する発光ユニット54が平面状のマウ ント56に配列されている。なお、発光ユニット54 は、第1実施形態の場合と同様に、複数の半導体レーザ LDおよびコリメータレンズ26によって構成されてい

【0028】この場合、各半導体レーザレDから出力さ れたレーザビームLのファーフィールドパターンは、平 行光束であるため、第0レンズ58によって第1レンズ 18の前側焦点位置で交差するように屈折された後、前 記第1レンズ18に入射する。 第1レンズ18を通過し たレーザビームしは、第1実施形態の場合と同様に、第 1レンズ18で平行光束とされ、そのファーフィールド パターンがアパーチャ部材20の面上に結像される。次 いで、アパーチャ部材20を通過したレーザビームしが 第2レンズ22および第3レンズ24を介して記録フイ ルムFに集光されることで画像が形成される。

[0029]

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係るレー ザ記録装置によれば、レーザビームの少なくとも副走査 方向の幅を規制するアパーチャ部材上に前記レーザビー ムのファーフィールドパターンを結像させることによ り、レーザビームの少なくとも副走査方向に対する変動 を抑制し、且つ、効率的にレーザビームを記録媒体に導 くことができる。従って、経時的変化の影響によらず簡 易な構成で画像等を高精度に記録することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施形態のファーフィールドパターンを用 いたレーザ記録装置の斜視構成図である。

【図2】図1に示すレーザ記録装置の平面構成図であ る。

【図3】図1に示すレーザ記録装置における発光ユニッ トおよび第1レンズの拡大説明図である。

【図4】発光ユニットを構成する半導体レーザの構造お よびそれから出力されるレーザビームのニアフィールド パターンの説明図である。

【図5】図1に示すレーザ記録装置を構成するアパーチ ャ部材の正面説明図である。

【図6】半導体レーザから出力されたレーザビームのフ ァーフィールドパターンの説明図である。

【図7】二アフィールドパターンおよびファーフィール ドパターンの結像位置でのビーム径の説明図である。

【図8】ニアフィールドパターンおよびファーフィール ドパターンの結像位置でのビーム径の説明図である。

【図9】図8の状態においてファーフィールドパターン の結像位置にアパーチャ部材を配置した場合の説明図で ある。

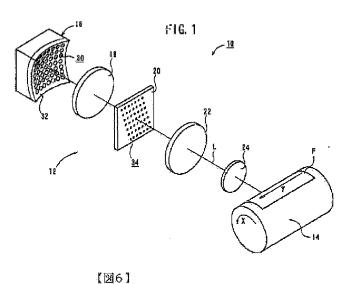
【図10】図1に示すレーザ記録装置において、第1レ ンズを光軸と直交する面内で所定距離ずらして設定した 状態の説明図である。

【図11】第2実施形態のファーフィールドパターンを 用いたレーザ記録装置の平面構成図である。

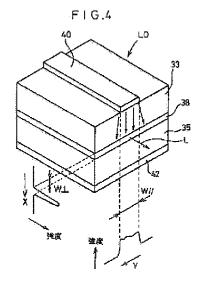
【符号の説明】

10、50…レーザ記録装置	12、52…露光
ヘッド	
14…ドラム	16、54…発光
ユニット	
18…第1レンズ	20…アパーチャ
部材	
22…第2レンズ	24…第3レンズ
26…コリメータレンズ	28…発光部
36…ビームスポット	58…第0レンズ
宜…記録フイルム	L.D・半適休レー

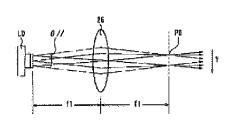
[図1]

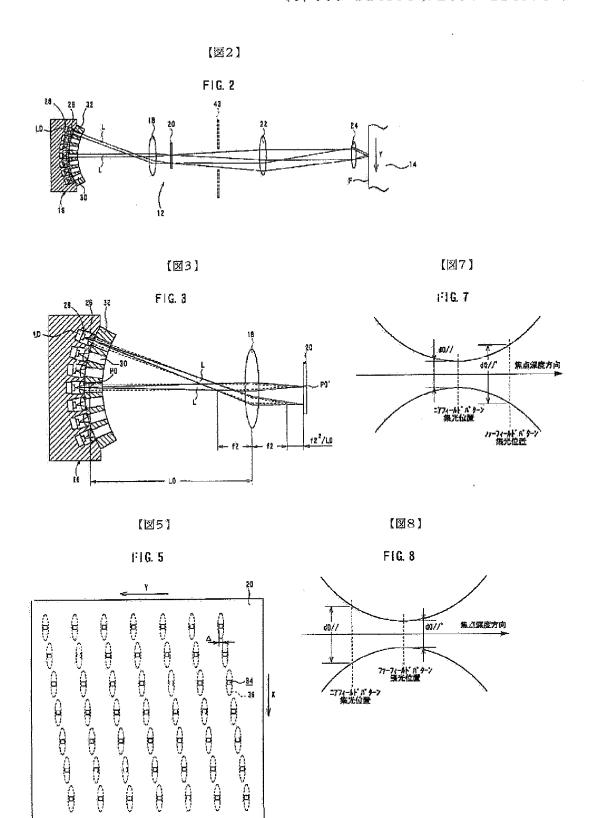


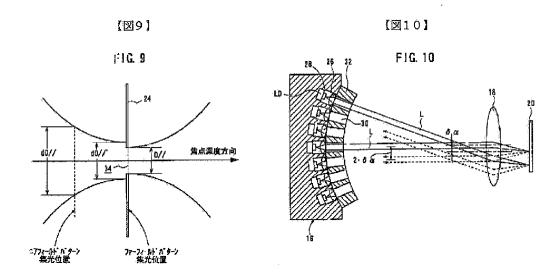
【図4】



F1G. 6







【図11】

